## アバランシェフォトダイオードディテクタを用いた 高計数率磁気回折測定システム

<u>細糸 信好</u><sup>a</sup>, 石地 耕太朗<sup>a</sup>, 早崎 有一<sup>a</sup>, 橋爪 弘雄<sup>a</sup>, 大河内 拓雄<sup>b</sup>, 表 和彦<sup>c</sup>, 栗林 勝<sup>c</sup>

<sup>\*</sup>奈良先端科学技術大学院大学・物質科学教育研究センター,<sup>b</sup>京都大学・化学研究所, <sup>\*</sup>理学電機・X線研究所

**背景**: 円偏光硬 X 線を用いた共鳴 X 線磁気 回折は、金属多層膜の元素選択的な磁気構造を 原子層の深さ分解能で決定することができる。 希土類金属の L 吸収端の場合、磁気散乱強度

(電荷-磁気干渉散乱強度と純電荷散乱強度 の比)は数%あり、磁気散乱を電荷散乱から分 離することは比較的容易である<sup>1)</sup>。しかし、3d 遷移金属の K 吸収端の場合、磁気散乱強度は 0.1%程度である。磁気散乱を電荷散乱から分 離するには、電荷散乱を少なくとも 10<sup>6</sup> カウン ト以上計数しなければならない。直線偏光であ る放射光から磁気散乱実験に必要な±ヘリシ ティの円偏光硬 X 線を得るのにダイヤモンド 移相子が使われる。この方法で得られた土円偏 光の強度は 3-6%程度異なっている。ディテク タが持つ不感時間のため、この強度差は反射率 の差 $I^{\dagger}(2\theta)$ - $I(2\theta)$ に人為的なピークを生じる。X 線計数に通常使われている Nal シンチレーシ ョンディテクタを磁気散乱測定に用いた場合、 人為ピークの影響を避けるために計数率は10<sup>4</sup> cps 以下にする必要がある。このため、3d 金属 K吸収端の磁気散乱測定は長時間を要する。共 鳴X線磁気散乱法をナノ磁性材料として重要 な 3d 強磁性金属に適用するには、高計数率の 測定装置が不可欠である。我々は、不感時間が 短いアバランシェフォトダイオードをディテ クタとして用いた計数装置を開発し、測定時間 を画期的に短くすることに成功した。

**実験**: 図1に実験に使用した計数装置の概 念図を示す。試料から散乱された X 線をアバ ランシェフォトダイオードディテクタ (APD)



図1 APD を用いた高計数率磁気散乱測定装置

で検出し、SR400 高速カウンタの ch.1 で計数 する(I<sup>+</sup>)。入射X線強度はイオンチェンバで測 定し、VF コンバータを通した後、SR400 の ch.2 で計数する(I<sup>±</sup>)。ダイヤモンド移相子を 0.1-10 Hzの矩形波で振動させてX線ヘリシティを周 期的に切り替えるとともに、この矩形波を計数 開始のトリガとして用いることにより $I^{\pm}$ と $I_{m}^{\pm}$ を X 線ヘリシティと同期して測定する。ファ ンクションジェネレータの信号と移相子の応 答には若干のずれがあるため、10 ms の遅延時 間を設定して、ずれを補償する。所定の時間測 定後、SR400 のメモリに保存された一連の Ⅰ<sup>±</sup> および  $I_m^{\pm}$ データから平均値< $I^+/I_m^+$ >および <Г//Im>を計算し、その差を取ることにより磁 気散乱差ピークを得る。測定には Co/Cu 多層 膜の1次反射を用い、X線エネルギーはCoK 吸収端近傍(7720 eV)を選んだ。また、APD の 前に Al フォイルを置き、その厚さを調整する ことにより磁気回折差ピークの計数率依存性 を調べた。

磁気回折差ピークの測定例 結果と考察: を図 2a-c に示す。移相子の振動数は1 Hz、各 点の計数時間は約10 s である。●は印加磁場 が X 線進行方向と平行、〇は反平行の場合の 磁気回折差ピークである。本来これらのピーク は、カウントゼロに対して正負対称になる。電 荷散乱ピークが 1.5×10<sup>6</sup> cps 程度の低計数率で は確かに磁気回折差ピークは対称的である。し かし、より計数率が高くなるとピーク形状は非 対称になり、1.0×10<sup>7</sup> cps では±磁場に対する差 ピークはいずれも正である。しかし図 3a で示 すように±磁場に対する磁気回折差ピークの 差を取ると 3.2×10<sup>7</sup> cps の場合を除いてほぼ一 定の形状となる。このことは、各データとも磁 気散乱シグナルは正しく測定されているが、他 の効果が対称なピーク形状を歪ませているこ とを示唆している。データ測定時の貯蓄リング の運転モードは 203-7×4 バンチであり、平均バ ンチ間隔は 27.3 ns に相当する。APD の不感時 間は 3.5 ns 程度で1 桁短い。このような状況で は数え落とし補正は、

 $I_{\rm corr} = [-\ln(1-q)]/q \times I_{\rm obs} \text{ (cps)}, \qquad (1)$ 

ただし  $q=I_{obs}(cps)/f_{ring}$  と与えられる。 $f_{ring}$  は 単位時間あたりのバンチ数で  $3.65 \times 10^7$  s<sup>-1</sup>で ある。(1)式を用いて補正を行なうと、図 2d-f



図2 磁気回折差ピーク形状の計数率依存性。 測定結果(左)と数え落とし補正後(右)



図3 様々なX線強度での磁気回折差ピークの差

のように計数率にかかわらず対称なピーク 形状が得られる。これは非対称形状の原因が X線の数え落としであり、(1)式を用いて正 しく補正できることを示す。数え落とし率 (%)を図2に示した。また、図3bで示すように 差ピークの差も計数率に依存せず同じになる。 つまり、APDとSR400を用いた計数装置を用 いれば、10<sup>7</sup> cps 程度の高計数率で共鳴X線磁 気回折が測定できることが分かる。

**今後の展望**: 本実験に先立ち、我々は APS/ANLで Co/Cu 多層膜の1次ピークの磁気 回折実験を Co K 吸収端で行い、約10時間か けて磁気回折ピークの検出に成功した。今回開 発した計数装置を用いれば同様の測定が1時 間以内に行なえる。これにより、3d 磁性元素 を含むナノ磁性薄膜・多層膜の磁気構造を系統 的に調べることが可能になった。また、Co/Cu 多層膜中の Cu 層誘起磁気分極のような微小磁 気分極も研究対象とすることができる。今後、 このような方向へ研究を発展させる予定であ る。

## 参考文献

 N. Ishimatsu, H. Hashizume, S. Hamada, N. Hosoito, C.S. Nelson, C.T. Venkataraman, G. Srajer and J.C. Lang, Phys. Rev. B60(1999) 9596.

## <u> 発表論文</u>

[1] 早崎有一,石地耕太朗,細糸信好,橋爪 弘雄,栗林勝,表和彦,日本物理学会 2003 年 秋季大会(発表予定)